2.11. Tranzystory krzemowe małej mocy, przełączające

Typ	Zastosowanie	Obudowa nr rys.	Polaryzacja	Parametry dopuszczalne graniczne /t_{amb} = 25°C/					Parametry charakterystyczne /t_{amb} = 25°C/																
				U_{CB}	U_{CE}	U_{EB}	I_C	P_{tot}	h_{21E}	przy		f_T	przy		C_{22b}	przy	U_{BEsat}	U_{CEsat}	przy		t_{ON}	t_{OFF}	przy		
										U_{CE} /U_{CB}/	I_C		U_{CS}	I_C		U_{CB}			I_C	I_B			I_C	I_{B1}	I_{B2}
				V	V	V	mA	mW	-	V	mA	MHz	V	mA	pF	V	V	V	mA	mA	ns	ns	mA	mA	mA
				max	max	max	max	max	min-max	-	-	min	-	-	max	-	min-max	max	-	-	max	max	-	-	-
BSXE 92	5/	83b	n-p-n	40	15	4,5	200	200	20-60	1	10	400	10	10	4	5	0,7-0,85	0,25	10	1	12	15	10	3	1,5
BSXE 93	5/	83b	n-p-n	40	15	4,5	200	200	40-120	1	10	500	10	10	4	5	0,7-0,85	0,25	10	1	12	18	10	3	1,5
BSXE 94	5/	83b	n-p-n	40	15	4,5	200	200	20-150	1	10	400	10	10	4	5	0,7-0,9	0,25	10	1	15	30	10	3	1,5

1/ Sterowanie pamięci ferrytowych, układy przełączające.
2/ Uniwersalne
3/ Układy przełączające.
4/ Układy o dużej szybkości przełączania.
5/ Układy hybrydowe wykonywane techniką cienko- lub grubowarstwową.

2.12. Tranzystory krzemowe średniej i dużej mocy, wielkiej częstotliwości

Typ	Zastosowanie	Obudowa nr rys.	Polaryzacja	Parametry dopuszczalne graniczne /t_{amb} = 25°C					Parametry charakterystyczne /t_{amb} = 25°C/			
				U_{CE}	U_{CB}	U_{EB}	I_C	P_{tot}	f_T	h_{21E}	przy	
											I_C	U_{CE}
				V	V	V	A	W	MHz	-	mA	V
				max	max	max	max	max	typ	min	-	-
BLYP 22	1/	14	n-p-n	40	65	4	0,5	11[x]	400	10	250	5
BFYP 99	2/	6	n-p-n	40	65	4	0,35	0,8	400	10	250	5

1/ Wzmacniacze, generatory i powielacze dużej mocy w.cz.
2/ Sterowanie w stopniach mocy, generatorach i przedwzmacniaczach końcowych w.cz.
x/ przy t_{case} = 25°C

16
max 11,5
max 20,3
max 10,3
max 12,8
max 7,1
max 4,4
11
13
2,3max
7,5max
4max
3,5max
1,25max
1,25max
25max
4,3
B
E
C
1,35
2,54
2,54
4,5
2,3
10
45±3°
24±1
5,3-0,4
17
26min
5,8
26min
16
14
11,5
11
12,5
5
2,2max
18
25min
5,4max
25min
15
12,7min
5,3-0,4
A
K
12
2,3max
7,5max
4max
3,5max
1,25max
1,25max
25max
4,3
E
B
C
1,35
2,54
2,54
4,5
2,3

OSUDOWY